

100Gbaud InGaAs PIN PD Chip $\phi 10\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

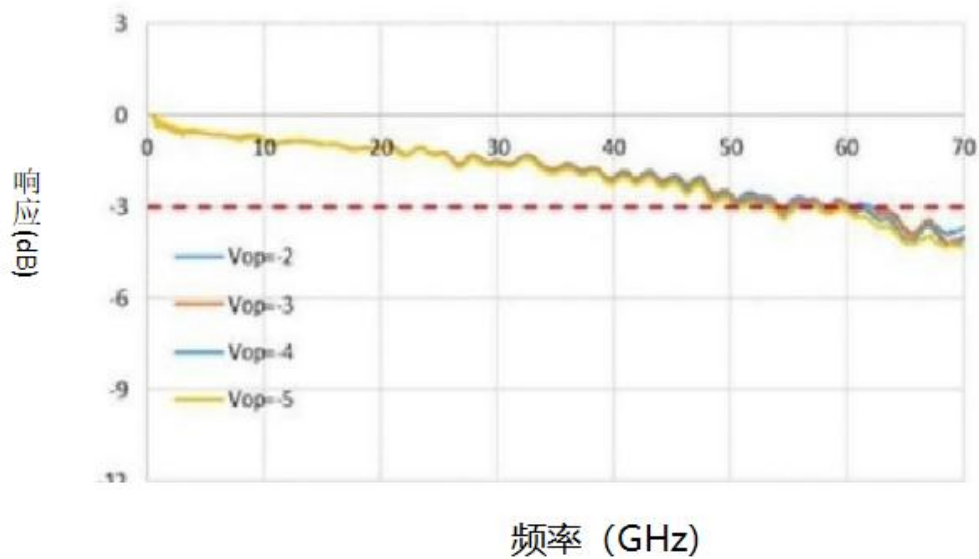
数据速率高达 200-800Gbps；底部发光平面结构；GSG 电极结构

应用领域

IEEE 200/800Gbps Ethernet | 200G CWD4, PSM4, LR4



详细参数



规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R		0.7		A/W	$\lambda=1310-1550\text{nm}$
暗电流	I_D		0.1	1	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.06		pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		60		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, RL=50 Ω
有效区直径	D		10		μm	
通道之间的中心间距 (pitch)			750/500		μm	